

Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, выпуск 7

Электронные свойства полупроводников

Алекперов А.С., Дашдемиров А.О., Нагиев Т.Г., Джаббаров С.Г.

Влияние гамма-облучения на эффект термопереключения монокристалла GeS : Nd

537

Rodrigues Cloves G.

Electron Mobility in Bulk n-Doped SiC-polytypes 3C-SiC, 4H-SiC and 6H-SiC: a comparison

541

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Рыжов В.А., Мелех Б.Т., Казакова Л.П.

Оптические свойства фазопеременных материалов системы германий--сурьма-теллур составов $Ge_{14}Sb_{29}Te_{57}$ и $Ge_{15}Sb_{15}Te_{70}$ в дальнем инфракрасном диапазоне

542

Соболев Н.А., Калядин А.Е., Феклисова О.В., Якимов Е.Б.

Влияние деформации сжатия и растяжения на спектр дислокационной люминесценции в кремнии

550

Мынбаева М.Г., Смирнов А.Н., Мынбаев К.Д.

Оптические свойства квазиобъемных кристаллов нитрида галлия со структурой высокоориентированной текстуры

554

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Александров О.В.

Латентное накопление поверхностных состояний в МОП структурах после ионизирующего облучения

559

Aouati R., Djaaboube H., Bouabellou1 A., Taabouche A., Bouachiba Y., Daranfad O., Oudina A., Kharfi F.
Structural and Optical Properties of MgO Thin Films Prepared by Dip-Coating Process: Effect of Thickness

564

Осак Y.S.

Influence of Annealing Condition on Ultrasonically Sprayed ZnS Thin Films

565

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Афанасьев А.Н., Алексеев П.С., Грешнов А.А., Семина М.А.

Баллистическое течение двумерных электронов в магнитном поле

566

Давыдов С.Ю., Посредник О.В.

Модель контакта двумерного металла и графеноподобного соединения с учетом их взаимодействия

578

Qader I.N., Qadr H.M., Ali P.H.

Calculation of Lattice Thermal Conductivity for Si Fishbone Nanowire Using Modified Callaway Model

584

Talla J.A., Almahmoud E.A., Al-Khaza'leh K., Abu-Farsakh H.

Structural and Electronic Properties of Rippled Graphene with Different Orientations of Stone--Wales Defects: First-Principles Study

585

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Степанов Н.П., Калашников А.А., Урюпин О.Н.

Зонная структура и процессы в электронной системе кристаллов $(Bi_{2-x}Sb_x)Te_3$ ($0 < x < 2$) по данным оптических исследований в инфракрасном диапазоне

586

Углеродные системы

Рехвиашвили С.Ш., Бухурова М.М.

Молекулы фуллерена C_{60} под однослойным графеном на металлической подложке

592

Физика полупроводниковых приборов

Якимов А.И., Кириенко В.В., Блошкин А.А., Двуреченский А.В., Уткин Д.Е.

Влияние адгезионных слоев на плазмонное усиление фототока металлическими нанодисками в фотодетекторах ближнего ИК-диапазона на базе квантовых точек Ge/Si

596

Бабичев А.В., Колодезный Е.С., Гладышев А.Г., Денисов Д.В., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Харин Н.Ю., Паневин В.Ю., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Евтихий В.П., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю.

Поверхностно-излучающий квантово-каскадный лазер с кольцевым резонатором

602

Куницына Е.В., Пивоварова А.А., Андреев И.А., Коновалов Г.Г., Иванов Э.В., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П.

Неохлаждаемые фотодиоды для регистрации импульсного инфракрасного излучения в спектральном диапазоне 0.9-1.8 мкм

607

Малевская А.В., Калюжный Н.А., Малевский Д.А., Минтаиров С.А., Салий Р.А., Паньчак А.Н., Покровский П.В., Потапович Н.С., Андреев В.М.

Влияние внутренних отражателей на эффективность инфракрасных (850 нм) светодиодов

614

Lin Y.-C., Niu J.-S., Liu W.-C., Tsai J.-H.

Thermal Stability of HfO₂/AlGaIn/GaN Normally-Off Transistors with Ni/Au and Pt Gate Metals

618